

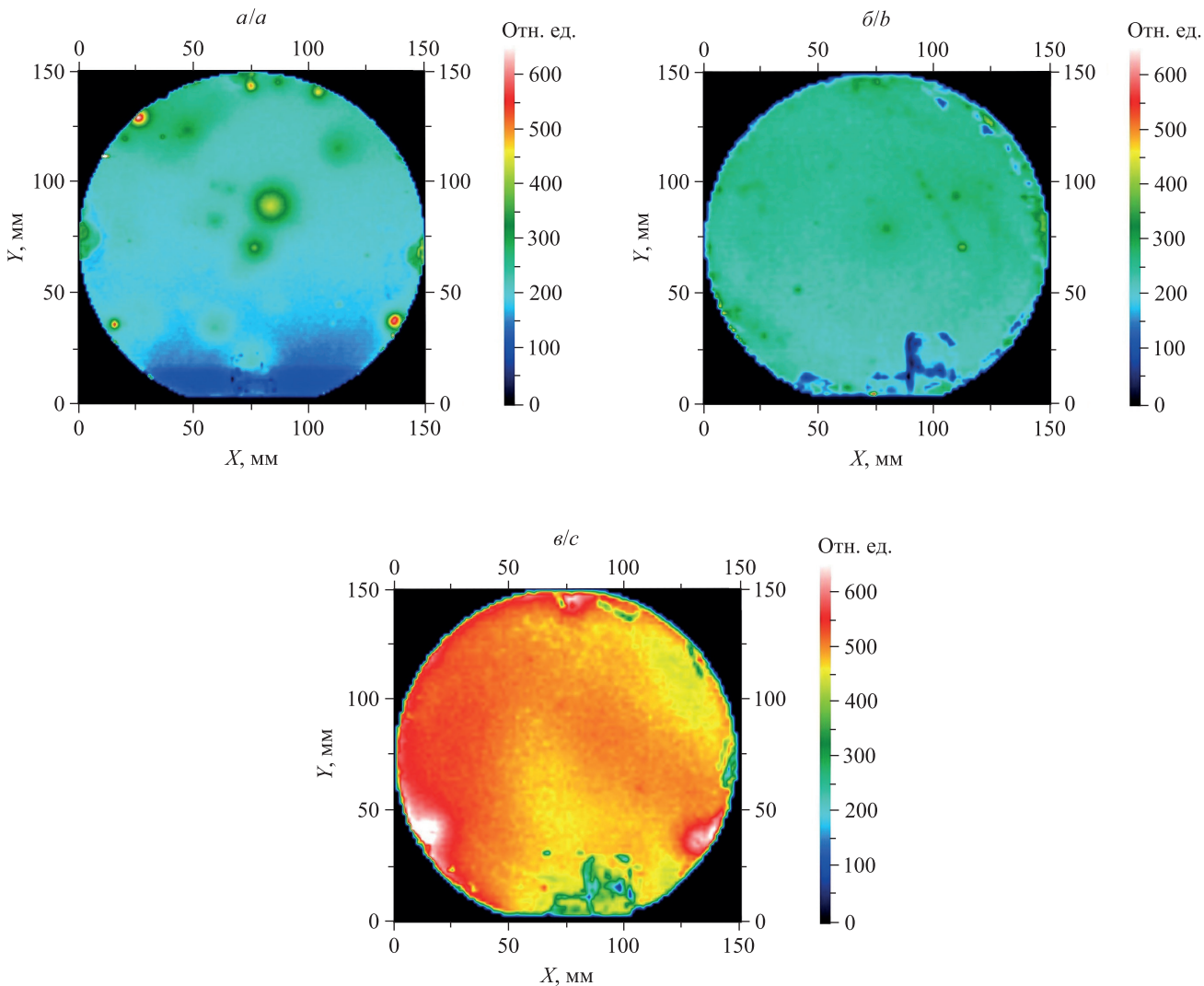


Рис. 2. Топограммы распределения потенциала (в относительных единицах) по поверхности пластин с диэлектриком, полученным методом БТО в ходе фотонных обработок длительностью 12 с при максимальной температуре 1250 °С: a – двухстадийный процесс в атмосфере O_2 ; $\bar{b}$, $\bar{c}$ – трехстадийный процесс с двумя обработками в атмосфере O_2 и третьей обработкой в атмосфере N_2 ($\bar{b}$) либо в формовочном газе ($\bar{c}$)

Fig. 2. Topograms of the potential distribution (in relative units) over the surface of plates with a dielectric obtained by the RTP method by photonic treatments with a duration of 12 s and a maximum temperature of 1250 °C: a – two-stage process in an O_2 atmosphere; b , c – three-stage process with two treatments in an O_2 atmosphere, the third treatment in N_2 atmosphere (b) or in forming gas (c)